



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Булевар краља Александра 73, П.Ф. 35-54, 11120 Београд, Србија

Тел: +381 11 3248464, Факс: +381 11 3248681

На основу чл.128 Закона о високом образовању и чл.66 и 68 Статута Електротехничког факултета, Наставно-научно веће Електротехничког факултета Универзитета у Београду, на седници од 21.01.2014. године, донело је

ОДЛУКУ

Усваја се извештај Комисије у саставу: др Јелена Радовановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Срђан Петровић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, Београд, др Витомир Милановић, професор емеритус, Електротехнички факултет у Београду, др Михалис Кокорис, доцент, Национални технички универзитет у Атини – Факултет за примењене математичке и физичке науке, др Небојша Нешковић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, др Пеђа Михајловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, о прегледу и оцени урађене докторске дисертације под насловом: **„Имплантација јона у канале кристала силицијума“** кандидата **мр Марка Ерића**.

Извештај се упућује на разматрање Већу научних области техничких наука, које је одлуком под бројем 06-8780/13-11 од 26.12.2011. године дало сагласност на предлог теме докторске дисертације.

Објављени научни радови кандидата у часописима међународног значаја:

1. **Erić, M.**, Petrović, S., Kokkoris, M., Lagoyannis, A., Paneta, V., Harissopulos, S., Telečki, I.: *Depth profiling of high energy nitrogen ions implanted in the <100>, <110> and randomly oriented silicon crystals*, - *Nucl. Instr. Meth. B*, vol. 274, pp. 87–92, 2012.
2. **Erich, M.**, Petrović, S., Kokkoris, M., Liarokapis, E., Antonakos, A., & Telečki, I.: *Micro-Raman depth profiling of silicon amorphization induced by high-energy ion channeling implantation*, - *J. Raman Spectrosc.*, vol. 44, pp. 496–500, 2013.

ДЕКАН

Електротехничког факултета

Проф. др Бранко Ковачевић